

9097250 TOSHIBA (DISCRETE/OPTO)

39C 01920 D T-31-23



SEMICONDUCTOR

TECHNICAL DATA

東芝トランジスタ TOSHIBA TRANSISTOR

2SC2036

SILICON NPN EPITAXIAL TYPE(PCT PROCESS)★

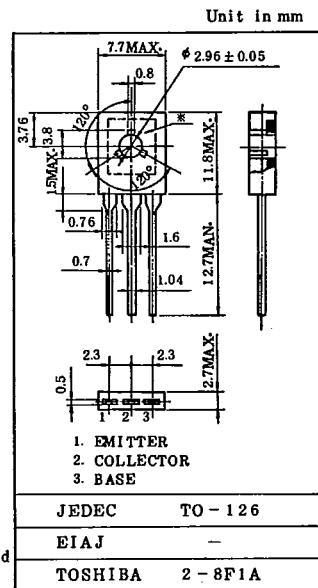
- 27MHz 高周波電力増幅用
- 27MHz RF Power Amplifier Applications
- 1Wトランシーバ送信部出力用および4Wトランシーバ励振用として適しています。
- Recommended for 1W Mobile Radio Output Stage and Driver Stage of 4W Transmitter

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CER}	80	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	5	V
コレクタ電流	I _C	1	A
エミッタ電流	I _E	-1	A
コレクタ損失	P _C	1	W
接合温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55~150	°C

注：※点線内のメタルはコレクタに接続されています。

The inside metal of dotted line is connected to collector lead.



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =60V, I _B =0	-	-	0.1	μA
コレクタシャ断電流	I _{CER}	V _{CE} =80V, R _{BE} =220Ω	-	-	0.1	mA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} =5V, I _C =0	-	-	0.1	μA
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} =2V, I _C =150mA	100	-	-	-
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C =500mA, I _B =20mA	-	-	0.7	V
ベース・エミッタ間電圧	V _{BE}	V _{CE} =2V, I _C =500mA	-	0.9	-	V
トランジション周波数	f _T	V _{CE} =10V, I _C =100mA	-	150	-	MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} =10V, I _B =0, f=1MHz	-	12	-	pF

★PCT技術により製造されています。

Produced by Perfect Crystal Device Technology.

TOSHIBA CORPORATION

2SC--02036-1X

105

1661

9097250 TOSHIBA (DISCRETE/OPTO)

39C 01921 0 T-31-23

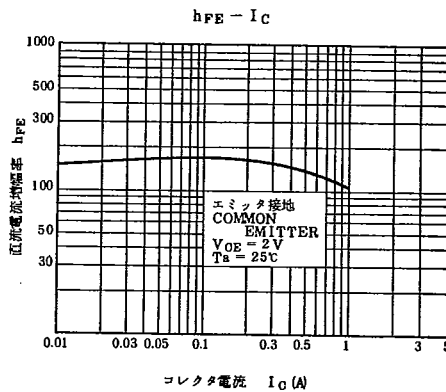
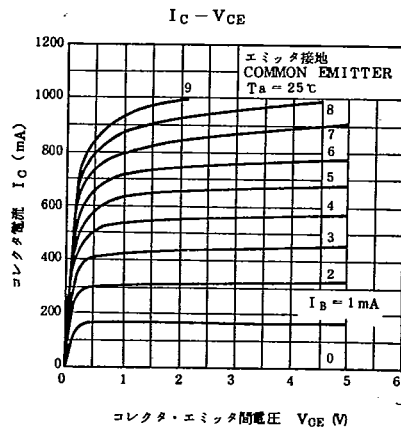
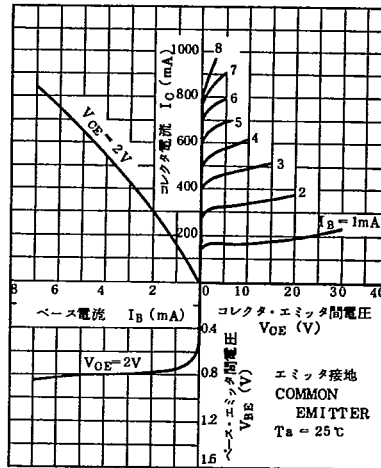


SEMICONDUCTOR

TECHNICAL DATA

2SC2036

STATIC CHARACTERISTICS



106

1662

TOSHIBA CORPORATION

2SC--02036-2X

9097250 TOSHIBA (DISCRETE/OPTO)

39C 01922 D T-3123

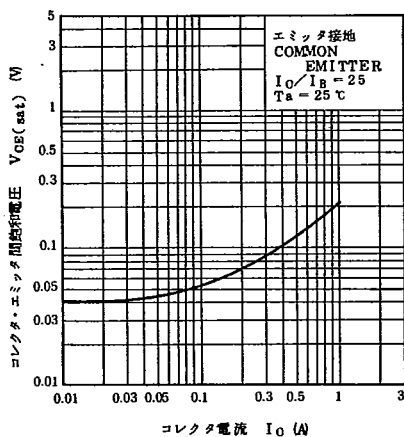


SEMICONDUCTOR

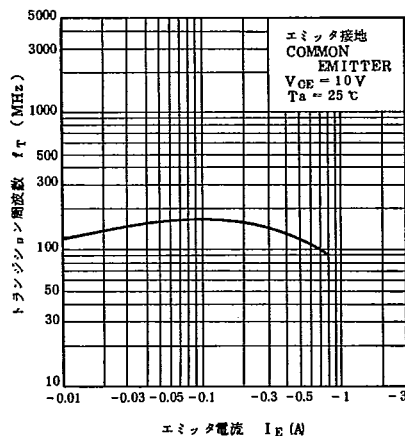
TECHNICAL DATA

2SC2036

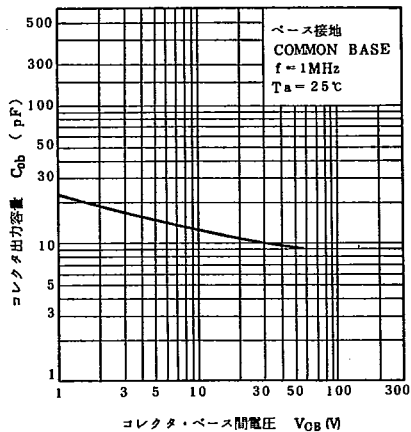
$V_{CE(sat)} - I_C$



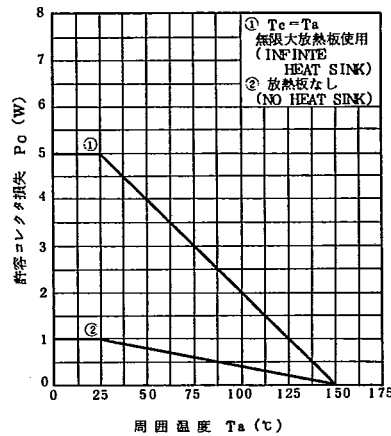
$f_T - I_E$



$C_{ob} - V_{CB}$



$P_C - T_a$



TOSHIBA CORPORATION

2SC--02036-3X

107

1663